

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 岸野 克巳

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 95 回委員総会・第 99 回研究会 開催案内

日時：平成 28 年 7 月 22 日（金）

委員総会： 12:00 - 12:50

研究会： 13:00 - 18:00

場所： 天満研修センター（JR「天満駅」より徒歩 2 分）

〒530-0034 大阪市北区錦町 2-21

TEL： 06-6354-1927 <http://www.temmacenter.com/tenma/access.html>

委員総会

議題：

- (1) 前回第 94 回委員総会 議事要録 承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) H27 年度収支決算について
- (4) H28 年度予算案について
- (5) 第 100 回研究会・記念シンポジウム(10/28)について
- (6) 次回第 100 回研究会以降の研究会について
- (7) 学振 162 委員会特別貢献賞の授与について
- (8) その他

報告事項：

- (1) 特別事業への応募について
- (2) LEDIA'16 (5/18-20：パシフィコ横浜)開催報告
- (3) 照明学会 LS15(5/22-27：京都大学)の開催報告
- (4) EMS-35 (7/6-8：ラフォーレ琵琶湖)開催報告
- (5) ICCGE-18 開会式(8 月 8 日)についてのご案内
- (6) その他

研究会 主 題：「GaN 縦型パワーデバイス研究開発の進展」

「委員長挨拶」 (13 : 00 - 13 : 05)

1. (イントロダクション) 「GaN 縦型パワーデバイス実現に向けた課題」 (13 : 05 - 13 : 20)

須田 淳 (京都大学) (本研究会企画 主担当)

2. 「GaN バルク基板およびホモエピ技術」 (13 : 20 - 14 : 10)

柴田 真佐知 (株式会社サイオクス)

3. 「GaN へのイオン注入およびデバイス試作」 (14 : 10 - 15 : 00)

中村 徹、三島 友義 (法政大学)

休憩 (15 : 00 - 15 : 20)

4. 「ホモエピタキシャル p-GaN 上 MOSFET の特性」 (15 : 20 - 16 : 10)
高島 信也 (富士電機株式会社)
5. 「GaN 縦型 SBD およびトレンチ MOSFET」 (16 : 10 - 17 : 00)
岡 徹、伊奈 務、上野 幸久、西井 潤弥、
田中 成明、長谷川 一也、安西 孝太、村上 倫章 (豊田合成株式会社)
6. 全講演者によるパネル討論会 (17 : 00 - 18 : 00)
GaN 縦型パワーデバイスについて総合的討論会。GaN 縦型パワーデバイスの展望、
集中して取り組むべき重要課題について議論。会場からの意見・質問に対する議論
も行う。

<追記>

1. 7月22日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を7月13日(水)までに日本学術振興会研究事業課 須賀 様
(jigyouka06@jsps.go.jp)宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。